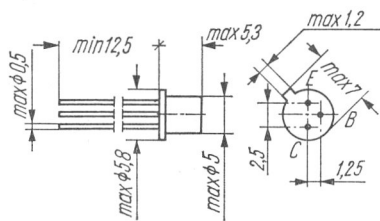


BFY19



Rys. 1-597. BFY19

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: ITT

Wykonanie: tranzystor krzemowy planarny *n-p-n* w obudowie metalowej TO-18, kolektor połączony z obudową, ciężar około 0,45 G

Zastosowanie: wzmacniacze pośredniej częstotliwości

Typy podobne: BSX48, BCY58 (Siem), SF132 (RFT)

Wartości charakterystyczne¹⁾

	min	typ	max		
I_{CBO}		0,3	10	nA	przy $U_{CB} = 9$ V
I_{CEO}		0,4	40	nA	przy $U_{CE} = 9$ V
I_{EBO}		2,5	20	nA	przy $U_{EB} = 1,5$ V
U_{CEsat}		85	140	mV	przy $I_C = 20 \mu A, I_B = 2,5 \mu A$
U_{CEsat}		100	140	mV	przy $I_C = 0,1$ mA, $I_B = 8 \mu A$
U_{CEsat}		170	270	mV	przy $I_C = 1$ mA, $I_B = 40 \mu A$
U_{CEsat}		1,3	2	V	przy $I_C = 10$ mA, $I_B = 330 \mu A$
U_{CEsat}		4,8	8	V	przy $I_C = 30$ mA, $I_B = 1,2$ mA
U_{BEsat}		0,56	0,58	V	przy $I_C = 20 \mu A, I_B = 2,5 \mu A$
U_{BEsat}		0,60	0,61	V	przy $I_C = 0,1$ mA, $I_B = 8 \mu A$
U_{BEsat}		0,67	0,69	V	przy $I_C = 1$ mA, $I_B = 40 \mu A$
U_{BEsat}		0,78	0,86	V	przy $I_C = 10$ mA, $I_B = 330 \mu A$
U_{BEsat}		0,86	1	V	przy $I_C = 30$ mA, $I_B = 1,2$ mA
h_{21E}	50	100			przy $U_{CE} = 9$ V, $I_C = 10$ mA
C_{22b}			4	pF	przy $U_{CB} = 6$ V, $I_E = 0$
f_T	300	400		MHz	przy $U_{CE} = 9$ V, $I_C = 10$ mA
h_{21e}	35		200		przy $U_{CE} = 9$ V, $I_C = 10$ mA, $f = 1$ kHz
F		7	13	dB	przy $U_{CE} = 2$ V, $I_C = 0,5$ mA $R_G = 600 \Omega, f = 1$ kHz
G_{pe}		26		dB	przy $I_C = 7,2$ mA
y_{11e}		$4 + j 4,45$		mS	} przy $U_{CE} = 9$ V, $I_C = 5$ mA, $f = 40$ MHz
y_{12e}		$-0,05 - j 0,4$		mS	
y_{21e}		$47,5 - j 44,5$		mS	
y_{22e}		$0,46 + j 1,15$		mS	

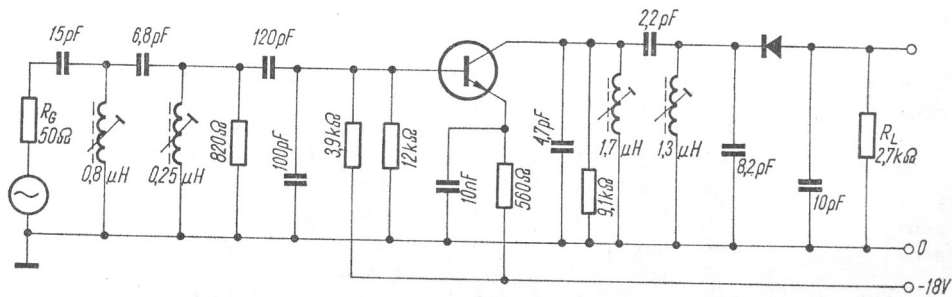
¹⁾ $t_j = 25^\circ C$

Wartości graniczne

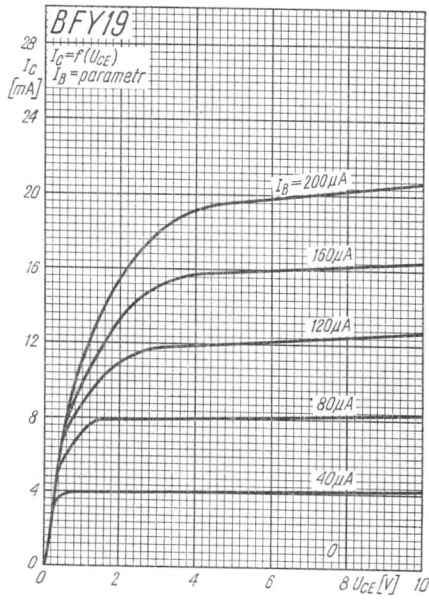
$U_{CB0 \text{ max}}$	30	V	$P_{tot \text{ max}}$	1 ³⁾	W
$U_{CEO \text{ max}}$	20	V	$R_{th \text{ j-a max}}$	500	°C/W
$U_{EB0 \text{ max}}$	5	V	$R_{th \text{ j-c max}}$	150	°C/W
$I_C \text{ max}$	100	mA	$t_j \text{ max}$	175	°C
$P_{tot \text{ max}}$	0,32 ²⁾	W	t_{stg}	-55 ÷ +175	°C

²⁾ $t_{amb} = 25^\circ\text{C}$

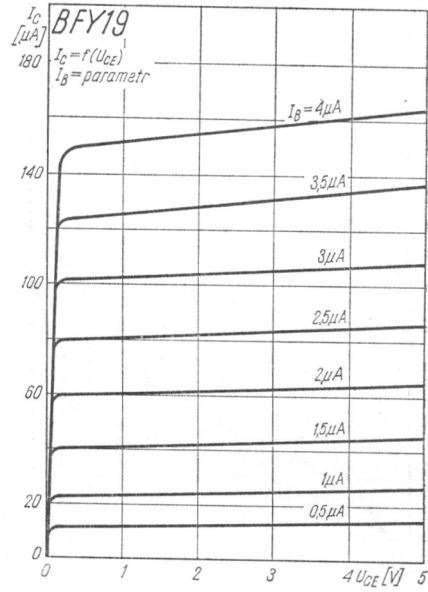
³⁾ $t_{case} = 25^\circ\text{C}$



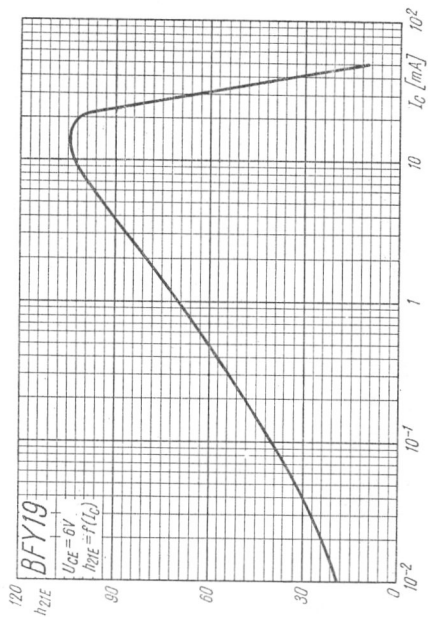
Rys. 1-598. Układ wzmacniacza pośredniej częstotliwości przy $f = 35 \text{ MHz}$



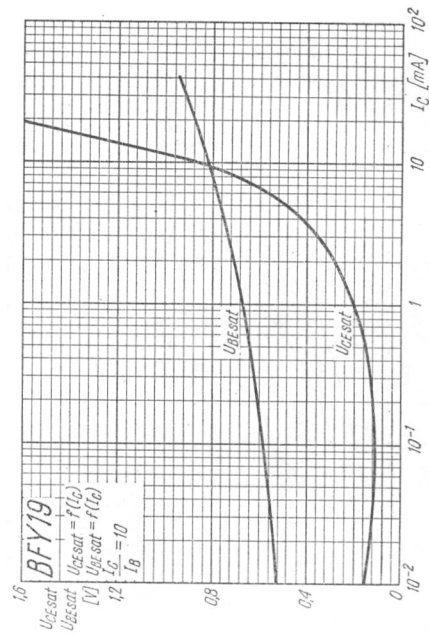
Rys. 1-599. Charakterystyki wyjściowe



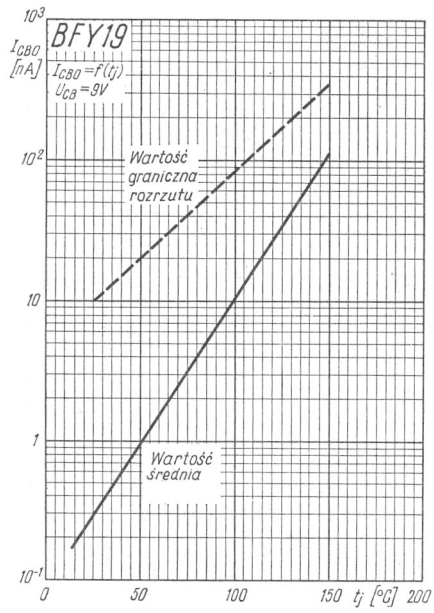
Rys. 1-600. Charakterystyki wyjściowe



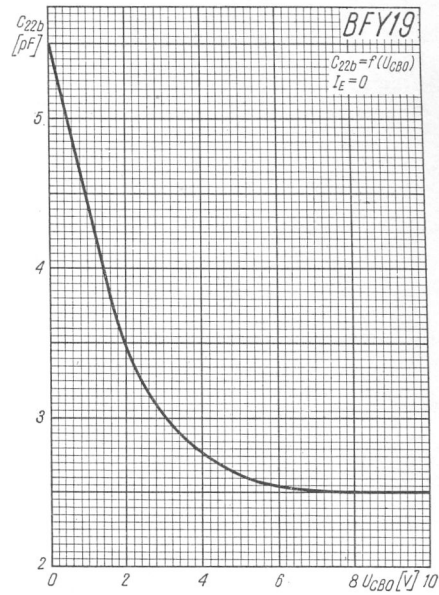
Rys. 1-601. Zależność współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora



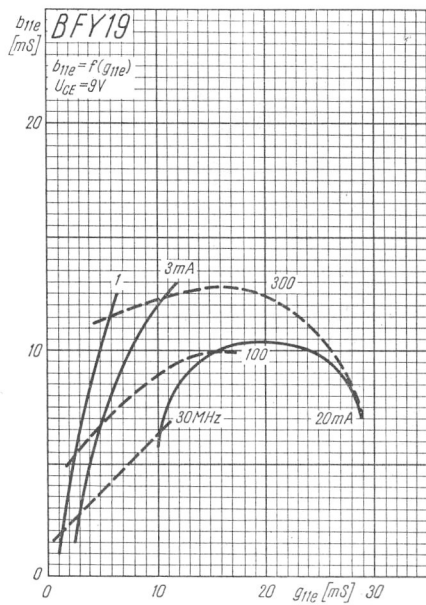
Rys. 1-602. Zależność napięcia nasycenia od prądu kolektora



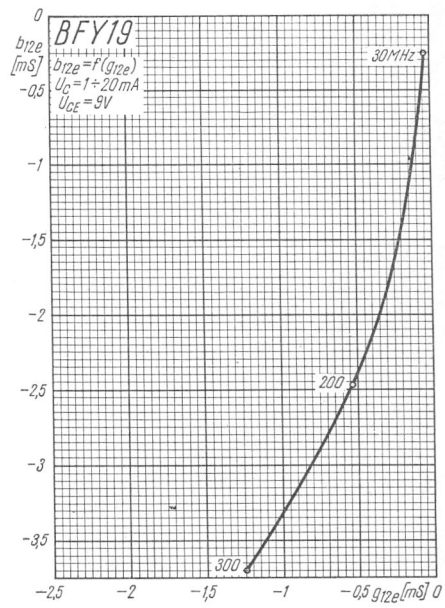
Rys. 1-603. Zależność prądu zerowego kolektora od temperatury złącza



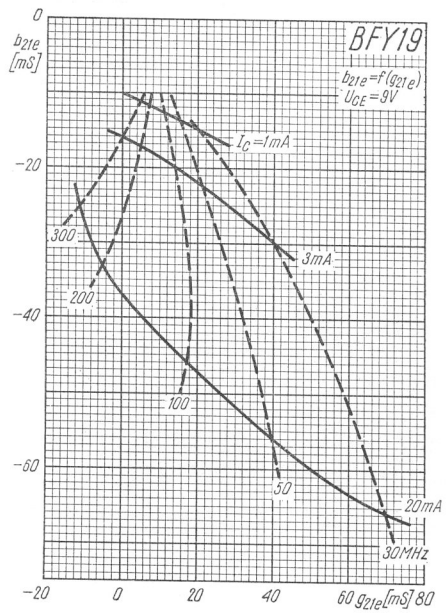
Rys. 1-604. Zależność napięciowa pojemności wyjściowej w układzie OB



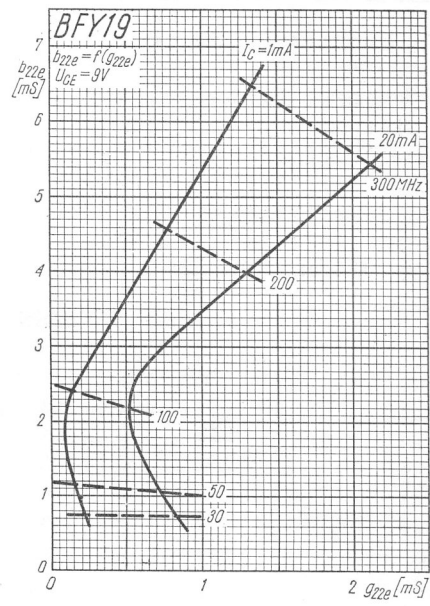
Rys. 1-605. Zależność admittancji wejściowej w układzie OE



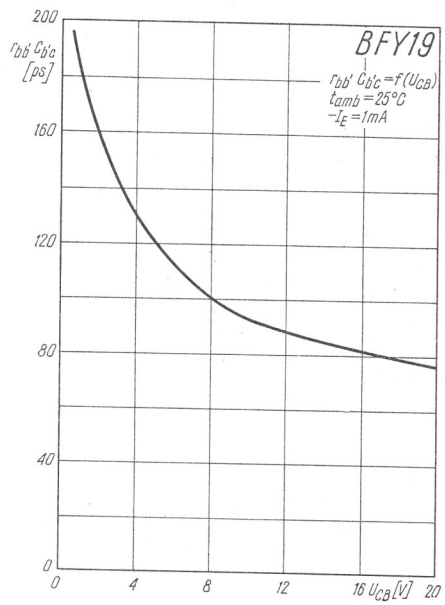
Rys. 1-606. Zależność admittancji zwrotnej w układzie OE



Rys. 1-607. Zależność admitancji przejściowej w układzie OE



Rys. 1-608. Zależność admitancji wyjściowej w układzie OE



Rys. 1-609. Zależność stałej czasu od napięcia kolektor-baza